

1. Dispozitiv semiconductor de tip varactor în baza diodei Schottky, care include un substrat semiconductor ce conține o regiune structurată și contacte ohmice, caracterizat prin aceea că regiunea structurată este formată poroasă, porii căreia sunt îndepărtați perpendicular suprafeței, totodată raportul adâncimii regiunii poroase către distanța dintre porii scheletului poros este mai mare ca zece.
2. Procedeu de obținere a dispozitivului semiconductor de tip varactor, care include decaparea substratului de semiconductor și depunerea contractului metalic de tip Schottky și a contractelor ohmice, caracterizat prin aceea că decaparea substratului se înfăptuiește pe cele electrochimică, iar depunerea contractului metalic de tip Schottky se execută prin aplicarea impulsurilor de tensiune în soluție de electrolit.